

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของปัญหา

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่มีปริมาณมาก สะอาดและไม่มีมลพิษ สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละประเภทมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเข้มของแสง, อุณหภูมิ, วัสดุที่ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์จึงควรมีความเข้าใจคุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงพลังงานแสงอาทิตย์มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานอย่างมากจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อการเรียนรู้คุณสมบัติและประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของแผงพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (I) และแรงดัน (V) ของเซลล์แสงอาทิตย์ได้
3. เพื่อจัดทำแบบจำลองที่ใช้ในการหาจุดสูงสุดในการจ่ายกำลังงาน (Maximum Power Point, MPP)
4. เพื่อเป็นการให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ

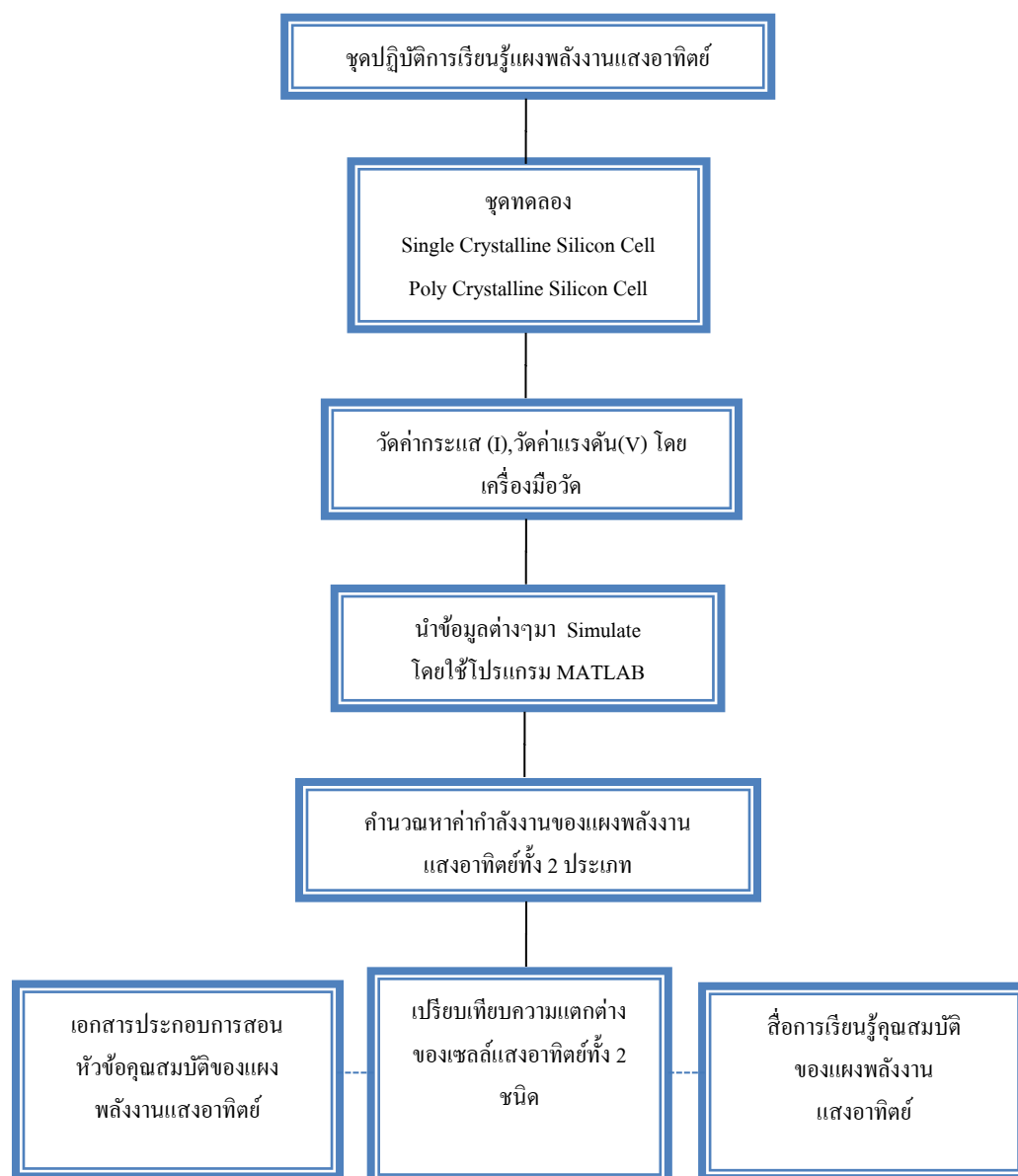
1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. สร้างชุดทดลองการทดสอบพลังงานแสงอาทิตย์ 2 แบบได้แก่
 - 1.1 Poly Crystalline Silicon Cell ขนาด 20 Watts
 - 1.2 Single Crystalline Silicon Cell ขนาด 30 Watts
2. จัดทำชุดโหนด จำนวน 8 ชุด
3. จัดหาเครื่องวัดกระแสและแรงดัน

4. ทดสอบคุณสมบัติความสัมพันธ์ต่างๆ ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งาน
5. ใช้โปรแกรม MATLAB ช่วยในการแสดงกราฟความสัมพันธ์
6. ออกแบบเอกสารประกอบการสอน หัวข้อ ปฏิบัติคุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์
7. จัดทำสื่อการเรียนรู้คุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Software)

1.4 โครงสร้างของโครงการ

โครงสร้างของโครงการแสดงได้ดังภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างของโครงการ

1.5 ประโยชน์ของโครงการ

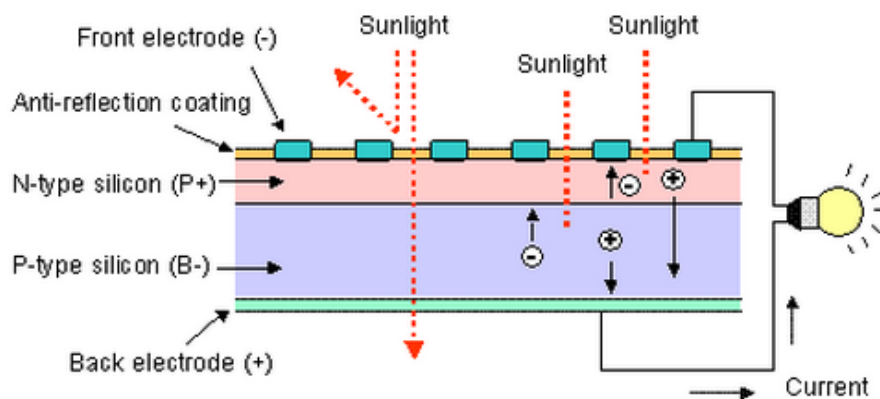
1. ทำให้เข้าใจคุณสมบัติและพฤติกรรมของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ
2. ทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (I) กับแรงดัน (V) ของเซลล์แสงอาทิตย์
3. ได้แบบจำลองที่ใช้ในการหาจุดสูงสุดในการจ่ายกำลังงาน(Maximum Power Point, MPP)
4. เกิดการเรียนรู้ในการใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เซลล์แสงอาทิตย์ [2]

หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้างดงกล่าวไปใช้งานได้ตามภาพที่ 2.1

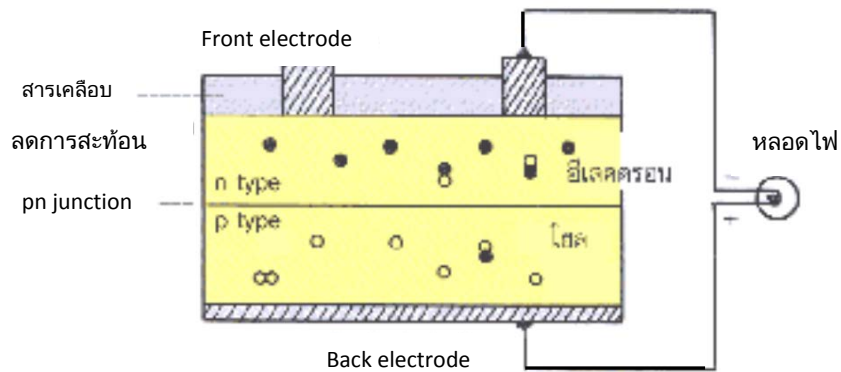


ภาพที่ 2.1 หลักการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ขั้นตอนการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์มีดังนี้

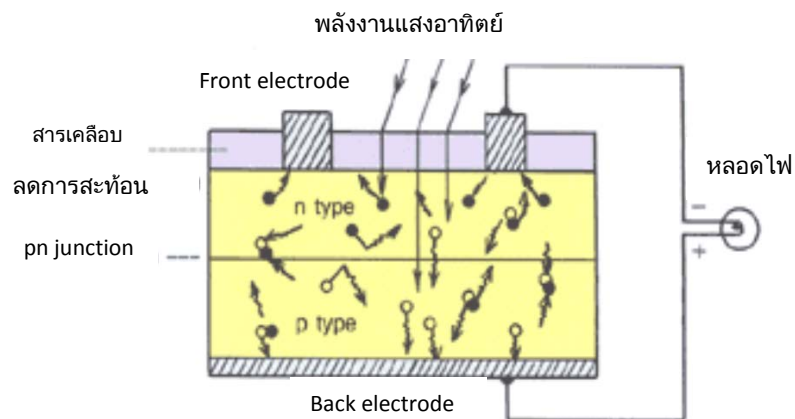
1. n - type ซิลิคอน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ คือ สารกึ่งตัวนำที่ได้อุปโภคด้วยสารฟอสฟอรัส มีคุณสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ p - type ซิลิคอน คือ สารกึ่งตัวนำที่ได้อุปโภคด้วยสารโบรอน ทำให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน (โฮล) เมื่อรับพลังงาน จากแสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน เมื่อนำซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกันด้วย p - n junction จึงทำให้เกิดเป็น " เซลล์แสงอาทิตย์ " ในสภาวะที่ยังไม่มีแสงแดด n - type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อมจะให้อิเล็กตรอน แต่ก็ยังมีโฮลปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย ด้านหน้าของ n - type จะมีแถบโลหะเรียกว่า Front Electrode ทำหน้าที่

เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ส่วน p - type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหลังของเซลล์ โครงสร้างส่วนให้เป็นโอสแต่ยังคงมีอิเล็กตรอนปะปนบ้างเล็กน้อย ด้านหลังของ p - type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะเรียกว่า Back Electrode ทำหน้าที่เป็นตัวรวบรวมโอส ตามภาพที่ 2.2



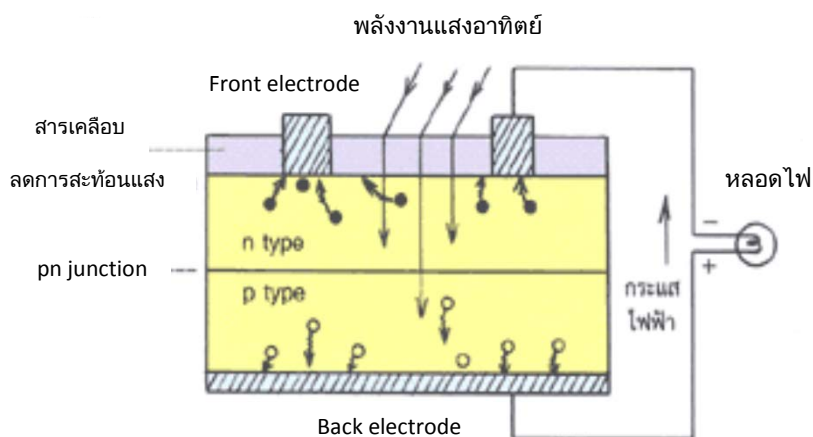
ภาพที่ 2.2 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

2. เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและโอสทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เมื่อพลังสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโอสจะวิ่งเข้าหาเพื่อจับคู่กัน อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังชั้น n - type และโอสจะวิ่งไปยังชั้น p type ตามภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

3. อิเล็กตรอนวิ่งไปรวมกันที่ Front Electrode และโฮลวิ่งไปรวมกันที่ Back Electrode เมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ Back Electrode ให้ครบวงจร ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เนื่องจากทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเพื่อจับคู่กัน ตามภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.4 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

2.2 ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์ [2]

เซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ

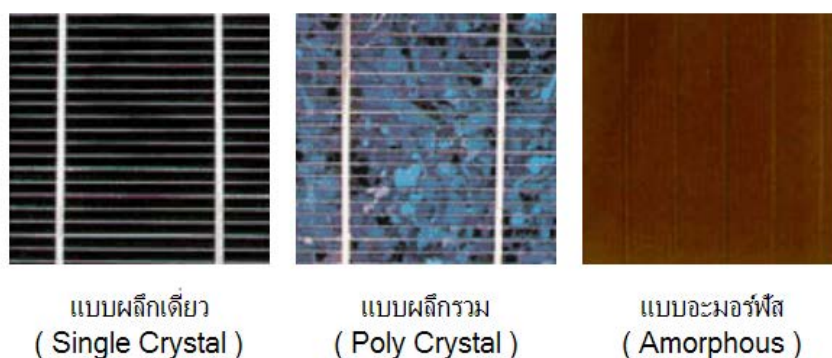
1. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้น คือ แบบที่เป็น รูปผลึก (Crystal) และแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) แบบที่เป็นรูปผลึก จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell) และ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก คือ ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)

2. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่งประเภทนี้จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แต่มีราคาสูงมาก ไม่นิยมนำมาใช้บนพื้นโลก จึงใช้งานสำหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่การพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่จะทำให้มีราคาถูกลงและนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต (ปัจจุบันนำมาใช้เพียง 7 % ของปริมาณที่มีใช้ทั้งหมด)

ในโครงการนี้จะกล่าวถึงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ผลิตจากซิลิกอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. ซิลิกอนแบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Cell)
2. ซิลิกอนแบบหลายผลึก (Poly Crystalline Silicon Cell)
3. ซิลิกอนแบบไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous Silicon Cell)

แสดงดังภาพที่ 2.5



ภาพที่ 2.5 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอนชนิดต่างๆ

2.3 คุณสมบัติและตัวแปรที่สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์

ตัวแปรที่สำคัญที่มีส่วนทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละพื้นที่ต่างกัน และมีความสำคัญในการพิจารณานำไปใช้ในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการนำไปคำนวณระบบหรือคำนวณจำนวนแผงแสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในแต่ละพื้นที่ มีดังนี้

1. ความเข้มของแสง กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง หมายความว่าเมื่อความเข้มของแสงสูง กระแสที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะสูงขึ้น ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานคือ ความเข้มของแสงที่วัดบนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวัดที่ระดับน้ำทะเลในสภาพที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ซึ่งความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100 mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 1,000 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้าแสงอาทิตย์ทำมุม 60 องศากับพื้นโลกความเข้มของแสง จะมีค่าเท่ากับประมาณ 75 mW ต่อ ตร.

ชม. หรือ 750 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM2 กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง

2. อุณหภูมิ กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 องศาที่เพิ่มขึ้น จะทำให้แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5% และในกรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่ใช้กำหนดประสิทธิภาพของแผงแสงอาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา C เช่น กำหนดไว้ว่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit Voltage หรือ Voc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าที่จะได้จากแผงแสงอาทิตย์ เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศา C จะเท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา C เช่น อุณหภูมิ 30 องศา C จะทำให้แรงดันไฟฟ้าของแผงแสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศา C) นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่ Voc จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 V (21V - 0.525V) สรุปได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่งมีผลทำให้กำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงแสงอาทิตย์ลดลงด้วย

2.4 ลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ [3]

พารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้อธิบายลักษณะสมบัติเอาต์พุต (Output Characteristics) ของเซลล์แสงอาทิตย์มีดังนี้

1. ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (Energy conversion efficiency) คืออัตราส่วนของกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุดต่อพลังงานของแสงที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ อาจเรียกสั้นๆ ว่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์และใช้สัญลักษณ์ว่า η เขียนเป็นสูตรได้ว่า

$$\text{ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์} = \frac{\text{กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด} \times 100\%}{\text{พื้นที่รับแสง} \times \text{กำลังของแสงที่ตกกระทบเซลล์}}$$

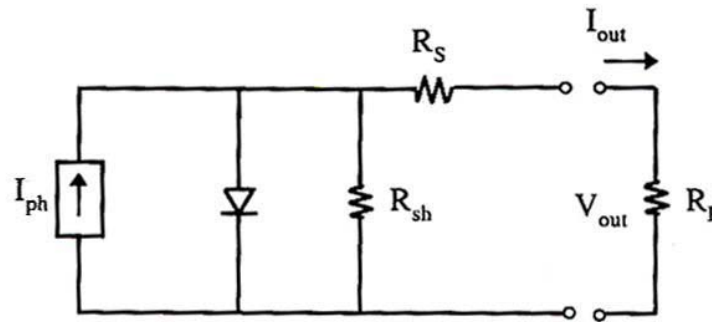
$$\eta = \frac{P_{max}(W)}{Area(m^2) \times P_{in}(W)} \times 100\% \quad (2.1)$$

โดยที่

η	คือ ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์
P_{max}	คือ กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด
$Area(m^2)$	คือ พื้นที่รับแสง

$P_{in}(W)$ คือ กำลังของแสงที่ตกกระทบเซลล์

2. กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit Current) ถ้าเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในสภาวะลัดวงจร เราเรียกกระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit Current: I_{SC})



ภาพที่ 2.6 วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป

ภาพที่ 2.6 แสดงวงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป ถ้าเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ถูกส่องด้วยแสง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ามีด I และแรงดันไฟฟ้า V ของเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะมีดจะมีรูปเหมือนกับสมการของกระแสไฟฟ้าของไดโอด กล่าวคือ

$$I_0 = qA \left[\frac{D_h p_n}{L_h} + \frac{D_e n_p}{L_e} \right] \quad (2.2)$$

$$I = I_0 \left[\exp\left(\frac{qV}{nkT}\right) - 1 \right] \quad (2.3)$$

โดยที่

- I_0 คือ กระแสไฟฟ้าย้อนอิมิตัว
- q คือ ประจุของอิเล็กตรอน ค่าคงที่ 1.6×10^{-19} C
- A คือ พื้นที่รับแสง
- D_h คือ สัมประสิทธิ์การแพร่ซึมของโฮล
- D_e คือ สัมประสิทธิ์การแพร่ซึมของอิเล็กตรอน
- L_h คือ ระยะทางแพร่ซึมของโฮล
- L_e คือ ระยะทางแพร่ซึมของอิเล็กตรอน
- n_p คือ จำนวนอิเล็กตรอนต่อพื้นที่ในชั้น p
- p_n คือ จำนวนโฮลต่อพื้นที่ในชั้น n

โดยที่ I_0 เรียกว่า กระแสไฟฟ้าย้อนอ้อมตัว และ n คือค่าแฟกเตอร์ I กระแสไฟฟ้าโฟโต I_{ph} (I_{sc}) ดังนี้

$$I_{out} = I - I_{ph} \quad (2.4)$$

ในที่นี้ $I_{ph}(= I_{sc})$ กำหนดได้จากสมการที่ 2.5 และถ้าให้ A คือพื้นที่รับแสง จะได้ว่า

$$I_{sc} = qA \int_0^\infty F(\lambda)\eta_{ext}(\lambda)d\lambda \quad (2.5)$$

โดยที่

$F(\lambda)$ คือ โฟตอนฟลักซ์ ซึ่งหมายถึงจำนวนโฟตอนต่อหน่วยพื้นที่และหน่วยเวลาที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์

$\eta_{ext}(\lambda)$ คือ ประสิทธิภาพการรวบรวมพาหะภายนอก

ถ้าพิจารณาความต้านทานภายในของเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งได้แก่ ความต้านทานอนุกรม R_s และความต้านทานขนั้ R_{sh} ด้วย จะทำให้กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต I_{out} มีค่าดังนี้

$$I_{out} = I_0 \left[\exp \left\{ \frac{q(V-IR_s)}{nkT} \right\} - 1 \right] + \frac{V-IR_s}{R_{sh}} - I_{ph} \quad (2.6)$$

โดยที่

I_0 คือ กระแสไฟฟ้าย้อนอ้อมตัว

q คือ ประจุของอิเล็กตรอน ค่าคงที่ 1.6×10^{-19} C

R_s คือ ความต้านทานอนุกรม

R_{sh} คือ ความต้านทานขนั้

I_{ph} คือ กระแสไฟฟ้าโฟโต

3. แรงดันไฟฟ้าวงจรมเปิด (Open Circuit Voltage) ถ้าเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ในสภาพวงจรมเปิด (Open circuit) แรงดันไฟฟ้าที่วัดได้เรียกว่า แรงดันไฟฟ้าวงจรมเปิด (Open Circuit Voltage: V_{oc}) ค่า V_{oc} กำหนดได้จากสมการที่ 2.7 โดยแทนค่า I_{out} ดังนั้นจึงได้ว่า

$$V_{oc} = \frac{nkT}{q} \ln \left[\frac{I_{sc}}{I_0} + 1 \right] \quad (2.7)$$

โดยที่

n คือ จำนวนอิเล็กตรอน

I_{sc} คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร

I_0 คือ กระแสไฟฟ้าย้อนอ้อมตัว

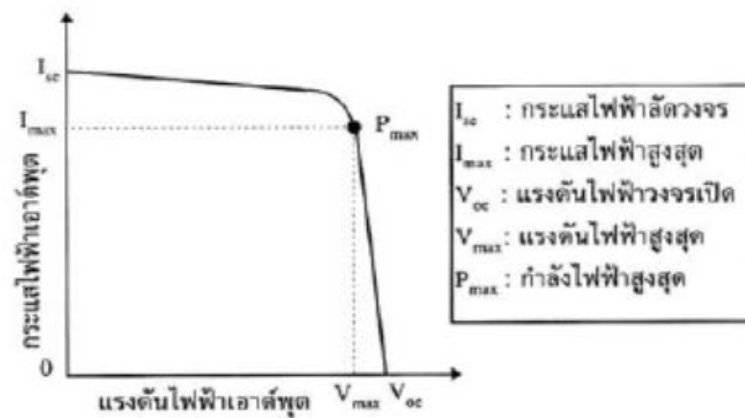
q คือ ประจุของอิเล็กตรอน ค่าคงที่ 1.6×10^{-19} C

ภาพที่ 2.7 แสดงตัวอย่างลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ จุดที่กราฟตัดแกนแรงดันไฟฟ้าคือแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด จุดที่กราฟตัดแกนกระแสไฟฟ้าคือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรในการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังไฟฟ้าสูงสุด P_{max} (Maximum Power) ที่เราจะได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใหญ่ที่สุดในกราฟลักษณะสมบัตินี้ซึ่งแสดงด้วยเส้นไขว่ปลาในรูปที่ 2.7 ถ้าให้ V_{max} (Maximum Voltage) และ I_{max} (Maximum Current) คือแรงดันไฟฟ้าสูงสุดและกระแสไฟฟ้าสูงสุดตามลำดับที่จะให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด ดังนั้น

$$P_{max} = V_{max} \times I_{max} \quad (2.8)$$

เราสามารถคำนวณหาค่า V_{max} ได้ด้วยการหาค่าอนุพันธ์ของ P_{max} เทียบกับ V_{max} และกำหนดให้

$$\frac{\partial P_{max}}{\partial V_{max}} = 0 \quad (2.9)$$



ภาพที่ 2.7 ลักษณะสมบัติเอาต์พุตของเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไป

$$\exp\left(\frac{qV_{max}}{nkT}\right) \left(1 + \frac{qV_{max}}{nkT}\right) = \left(\frac{I_{sc}}{I_0} + 1\right) \quad (2.10)$$

ด้วยวิธีการคำนวณในทำนองเดียวกัน I_{max} จะมีค่าเท่ากับ

$$I_{max} = \frac{(I_{sc} + I_0) \frac{qV_{max}}{nkT}}{1 + \frac{qV_{max}}{nkT}} \quad (2.11)$$

โดยที่

- I_{sc} คือ กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
- I_0 คือ กระแสไฟฟ้าย้อนอิมิตัว
- V_{max} คือ แรงดันไฟฟ้าสูงสุด
- q คือ ประจุของอิเล็กตรอน ค่าคงที่ 1.6×10^{-19} C

สมการที่ 2.9 และ 2.10 ซึ่งให้เราทราบว่า P_{max} จะมีค่ามากเมื่อ I_0 มีค่าน้อย (นั่นก็คือ ช่องว่างพลังงานของสารกึ่งตัวนำควรมีค่ากว้างพอสมควร) และ n มีค่าน้อย

4. ฟิลล์แฟกเตอร์ (Fill Factor) เอาต์พุตพารามิเตอร์ที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือ ฟิลล์แฟกเตอร์ (Fill Factor) เขียนย่อว่า FF นิยามของ FF คืออัตราส่วนของพื้นที่ของ $V_{max} \times I_{max}$ ต่อพื้นที่ของ $V_{oc} \times I_{sc}$ และเขียนเป็นสูตรได้ว่า

$$FF = \frac{P_{max}}{V_{oc} \times I_{sc}} = \frac{V_{max} \times I_{max}}{V_{oc} \times I_{sc}} \quad (2.12)$$

$$= \frac{V_{max}}{V_{oc}} \left[1 - \frac{\exp(qV_{max}/nkT) - 1}{\exp(qV_{oc}/nkT) - 1} \right] \quad (2.13)$$

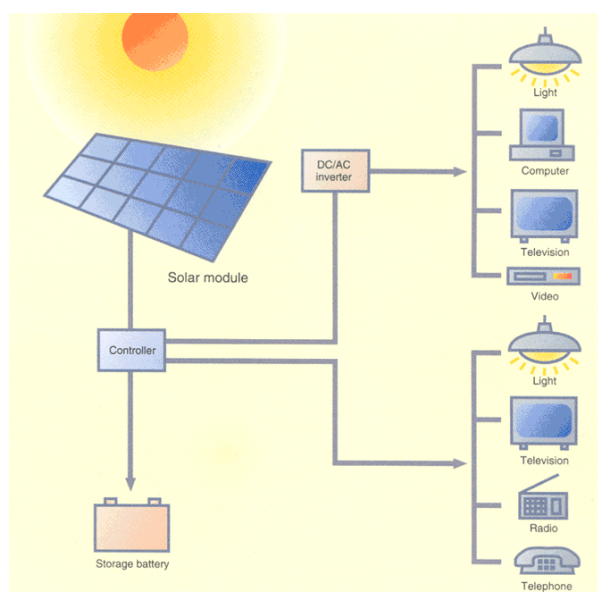
ถ้าความต้านทานอนุกรม R_s ในเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าน้อย จะทำให้ฟิลล์แฟกเตอร์ FF มีค่ามาก ถ้าเราทราบค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เราจะสามารถคำนวณค่าประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดังนี้

$$\eta = \frac{P_{max}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{V_{max} \times I_{max}}{P_{in}} = \frac{V_{oc} \times I_{sc} \times FF}{P_{in}} \times 100\% \quad (2.14)$$

2.5 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

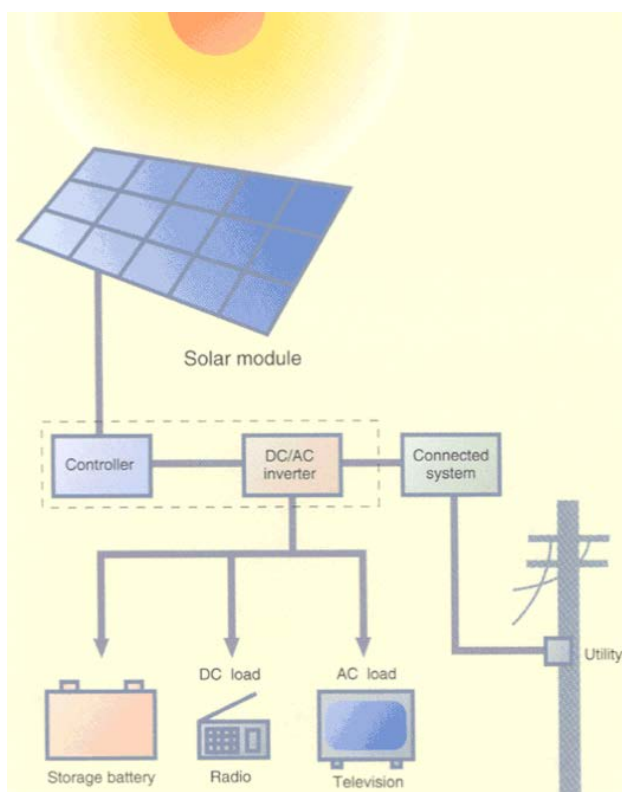
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

1. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand Alone System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ



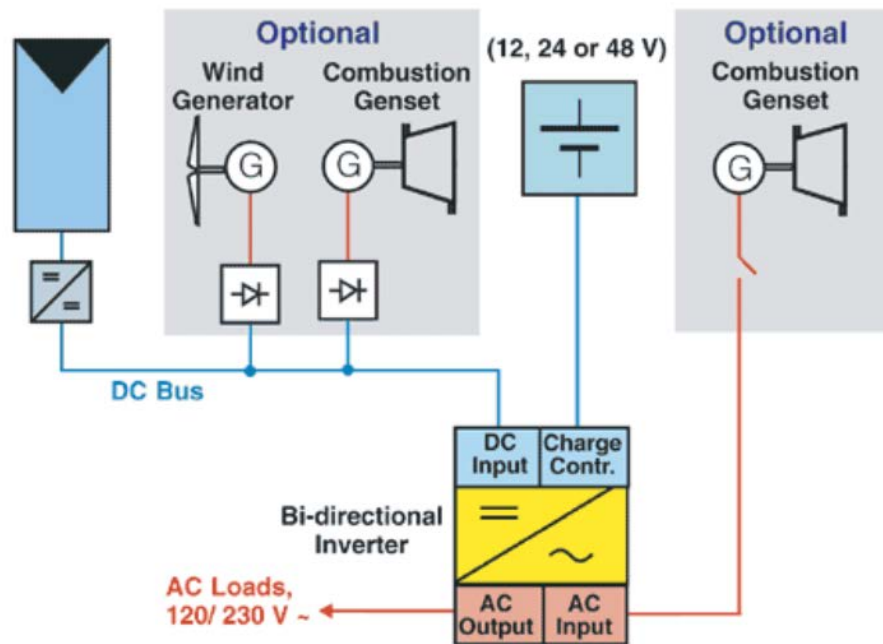
ภาพที่ 2.8 PV Stand Alone System

2. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย (PV Grid Connected System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า



ภาพที่ 2.9 PV Grid Connected System

3. การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับกรอกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ



ภาพที่ 2.10 PV Hybrid System

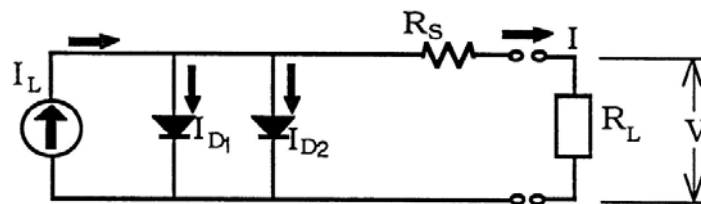
2.6 แบบจำลอง I-V [1]

แบบจำลอง I-V ที่จะกล่าวถึงนี้อ้างอิงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง A METHOD FOR ESTIMATING THE LONG-TERM PERFORMANCE OF DIRECT-COUPLED PHOTOVOLTAIC SYSTEMS โดย TIMOTHY U. TOWNSEND MASTER OF SCIENCE (Mechanical Engineering) I UNIVERSITY OF WISCONSIN – MADISON โดยมีทั้งหมด 6 แบบจำลองดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 I-V Curve Model

Acronym	Model Description
2M6P	Lumped,2 Mechanism model with 6 Parameters
2M5P	Lumped,2 Mechanism model with 5 Parameters
L4P	Lumped,1 Mechanism model with 4 Parameters
L3P	Lumped,1 Mechanism model with 3 Parameters
MIT	Mass. Inst. Fo Tech. model, developed by TRW Corp.; a hybrid between the L4P and L3P models, used in TRNAYA/MIT and also by New Mexico Solar Energy Inst.
LINEAR	Simple linear model for calculating maximum power output only; used in PV f-Chart, PVFORM, and other simplified programs.

1. Lumped, 2 Mechanism, 6 Parameter Equivalent Circuit แบบจำลอง I-V นี้เป็นการประเมินผลในระยษะขาวมี R_s (Series Resistance) ประกอบอยู่ด้วย โดยจะถูกเรียกว่าแบบจำลอง 2M6P ซึ่งมีวงจรสวมมูลดังภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 Two Mechanism, Six Parameter Equivalent Circuit
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็นดังนี้

$$I = I_L - I_{D1} - I_{D2} \quad (2.15)$$

$$I_{D1} = I_{o1} \left[\exp \left[\frac{q}{\gamma_1 k T_c} \times (V + I R_s) \right] - 1 \right] \quad (2.16)$$

$$I_{D2} = I_{o2} \left[\exp \left[\frac{q}{\gamma_2 k T_c} \times (V + IR_s) \right] - 1 \right] \quad (2.17)$$

$$I = I_L - I_{o1} \left[\exp \left[\frac{q[V+IR_s]}{\gamma_1 k T_c} \right] - 1 \right] - I_{o2} \left[\exp \left[\frac{q[V+IR_s]}{\gamma_2 k T_c} \right] - 1 \right] \quad (2.18)$$

6 Parameters ของวงจรนี้คือ

I_L = Light Current

I_{o1} = Reverse Saturation Current

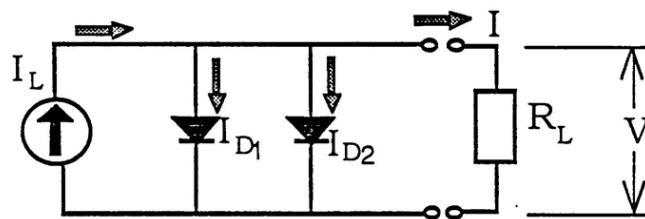
I_{o2} = Reverse Saturation Current

γ_1 = $A_1 \times$ (NCS)

γ_2 = $A_2 \times$ (NCS)

R_s = Series Resistance

2. Lumped, 2 Mechanism, 5 Parameters Equivalent Circuit แบบจำลอง I-V นี้มีความต้านทานเล็กน้อยหรือเทียบเท่าไม่มีความต้านทานเลยหรือไม่มี Series Resistance เรียกแบบจำลองนี้ว่า “2M5P” มีวงจรสมมูลดังภาพที่ 2.12



ภาพที่ 2.12 Two Mechanism, Five Parameter Equivalent Circuit
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็นดังนี้

$$I = I_L - I_{D1} - I_{D2} \quad (2.19)$$

$$I_{D2} = I_{o2} \left[\exp \left[\frac{qV}{\gamma_2 k T_c} \right] - 1 \right] \quad (2.20)$$

$$I = I_L - I_{o1} \left[\exp \left[\frac{qV}{\gamma_1 k T_c} \right] - 1 \right] - I_{o2} \left[\exp \left[\frac{qV}{\gamma_2 k T_c} \right] - 1 \right] \quad (2.21)$$

5 Parameters ของวงจรมันคือ

I_L = Light Current

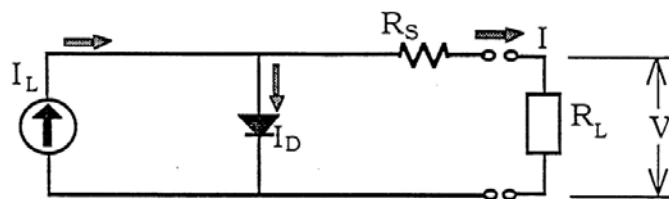
I_{o1} = Reverse Saturation Current

I_{o2} = Reverse Saturation Current

γ_1 = A1 x (NCS)

γ_2 = A2 x (NCS)

3. Lumped, 1 Mechanism, 4 Parameter Equivalent Circuit แบบจำลอง I-V นี้ตั้งสมมุติฐานโดยคิดกลไกเพียงไดโอดเพียงตัวเดียว มีวงจรมูลดังภาพที่ 2.13



ภาพที่ 2.13 Single Mechanism, Four Parameter Equivalent Circuit

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็นดังนี้

$$I = I_L - I_D \quad (2.22)$$

$$I_D = I_o \left[\exp \left[\frac{q}{\gamma k T_c} \times [V + IR_s] \right] - 1 \right] \quad (2.23)$$

$$I = I_L - I_{o1} \left[\exp \left[\frac{q}{\gamma k T_c} \times [V + IR_s] \right] - 1 \right] \quad (2.24)$$

4 Parameters ของวงจรมันคือ

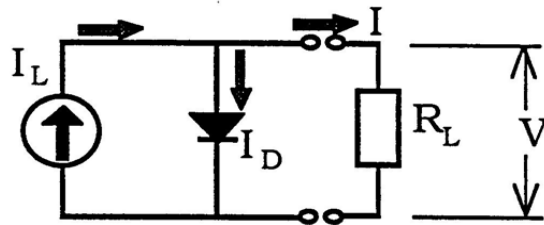
$$I_L = \text{Light Current}$$

$$I_O = \text{Reverse Saturation Current}$$

$$\gamma = A \times (\text{NCS})$$

$$R_S = \text{Series Resistance}$$

4. Lumped, 1 Mechanism, 3 Parameter Equivalent Circuit แบบจำลอง I-V นี้ความต้านทานเป็นศูนย์ และมีไดโอดเพียงตัวเดียวเพื่อจะอธิบายพฤติกรรมของไดโอดที่ไม่เหมาะสม มีวงจรมนูลดังภาพที่ 2.14



ภาพที่ 2.14 Single Mechanism Three Parameter Equivalent Circuit

ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็นดังนี้

$$I = I_L - I_D \quad (2.25)$$

$$I_D = I_O \left[\exp \left[\frac{q}{\gamma k T_c} \right] - 1 \right] \quad (2.26)$$

$$I = I_L - I_O \left[\exp \left[\frac{qV}{\gamma k T_c} \right] - 1 \right] \quad (2.27)$$

3 Parameters ของวงจรมันคือ

$$I_L = \text{Light Current}$$

$$I_O = \text{Reverse Saturation Current}$$

$$\gamma = A \times (\text{NCS})$$

5. MIT I-V Model Equivalent Circuit แบบจำลอง I-V นี้เป็นการผสมระหว่าง L3P และ L4P ซึ่งในโครงการนี้ได้เลือกใช้รูปแบบโมเดลนี้ เนื่องจากทำความเข้าใจได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็นดังนี้

$$I = I_{sc} \left[1 - C_1 \left(\exp \left(\frac{V}{C_2 V_{oc}} \right) - 1 \right) \right] \quad (2.28)$$

ค่าคงที่ C_1 และ C_2 หา ดังนี้

$$C_1 = \left(1 - \frac{I_{MP}}{I_{SC}} \right) \exp \left(\frac{-V_{MP}}{C_2 V_{OC}} \right) \quad (2.29)$$

$$C_2 = \frac{\frac{V_{MP}-1}{V_{OC}}}{\ln \left(1 - \frac{I_{MP}}{I_{SC}} \right)} \quad (2.30)$$

V_{MP} = Maximum power point voltage at reference conditions

I_{MP} = Maximum power point current at reference conditions

V_{oc} = Open circuit voltage

I_{sc} = Short circuit current

6. Linear Maximum Power Model แบบจำลอง I-V นี้เป็นแบบจำลองเชิงเส้นไม่สามารถอธิบาย I-V curve ได้ มีไว้สำหรับคำนวณกำลังสูงสุด (Maximum powerpoint) สมการที่ใช้สำหรับคำนวณกำลังสูงสุดเป็นดังนี้

$$P_{MAX} = \frac{\phi}{\phi_{REF}} P_{MAX,REF} \left(1 - \beta (T_C - T_{C,REF}) \right) \quad (2.31)$$

β = Manufacturer-supplied temperature coefficient of maximum power, 1/C

$P_{MAX}, P_{MAX,REF}$ = Maximum power output at new and reference condition, W

2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

1. การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดแผ่นตก โดย ธีรวุฒิ วงศ์สาลี, พงษ์ศิริ บุษปมาลัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 โดยทำการศึกษา กำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดมีแผ่นตกและไม่มีแผ่นตก และทำการเปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าของทั้งสองสถานะ [4]

2. เซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ตามตำแหน่งดวงอาทิตย์ โดย ชัชวาล เขียววิทย์พันธ์, ภาสกร พรเจริญ นพ.เอกชัย ว่องทรัพย์สิน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยโครงการนี้ออกแบบให้เซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปตามตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ซึ่งจะทำได้ทำให้สามารถเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยหลักการของตัวตรวจจับความเข้มของแสงเป็นตัววัดระดับแรงดันสูงสุดของแสงอาทิตย์ [5]

3. การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงอาทิตย์ โดย อุมารินทร์ แสงพานิช วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานวิจัยนี้ศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเรื่องแรงดันกระแสเพื่อมเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิกที่จุดเชื่อมต่อกับระบบที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มแสงอาทิตย์ในสถานะการทำงานจริง พารามิเตอร์ในการศึกษาได้แก่ความเข้มแสงอาทิตย์ กระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าเพาเวอร์แฟคเตอร์และฮาร์มอนิกที่จุดเชื่อมต่อกับระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคริสตอลไลน์ซิลิกอน [6]

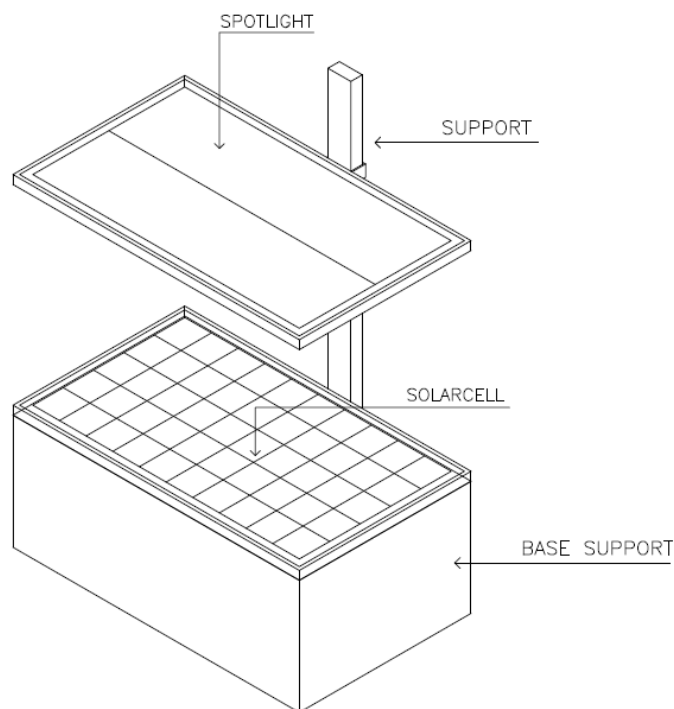
บทที่ 3

การออกแบบโครงงาน

โครงงานนี้มีแนวคิดที่จะออกแบบชุดทดลองให้เป็นสื่อการเรียนรู้ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ จึงเลือกที่จะออกแบบเป็นชุดทดลองที่ใช้ทดสอบแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Mono Crystalline Silicon Cell ขนาด 30 วัตต์ และแบบ Poly Crystalline Silicon Cell ขนาด 20 วัตต์ และชุดเครื่องมือวัดกระแส และ แรงดัน

3.1 โครงสร้างและส่วนประกอบ

การออกแบบชุดทดลองโดยสร้างฐานเป็นลักษณะคล้ายกล่องเพื่อเป็นฐานสำหรับรองรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และมีแหล่งกำเนิดแสงอยู่ด้านบนบนดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 แบบจำลองฐานสำหรับรองรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์

การออกแบบชุดเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆประกอบด้วย Ammeter DC, Voltmeter DC และความต้านทานปรับค่าได้โดยคำนวณค่าความต้านทานจากรายละเอียดข้อมูลจากผู้ผลิตตามภาพที่ 3.2

Specification

- Dimension of module: 430x330x30mm
- Weight: 2 kg
- Electrical Parameters
- Peak power (W_p): 20W
- Open circuit voltage (Voc): 22V
- Optimum power voltage (Vm): 18V
- Short Circuit Current (Isc): 1.19 A
- Optimum operation current (Im): 1.10 A

ภาพที่ 3.2 ข้อมูลของแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากทางผู้ผลิตขนาด 20 วัตต์

การคำนวณค่าความต้านทานที่ปรับค่าได้คำนวณจากสมการที่ 3.1 ดังนี้จากข้อมูลจะได้ว่า

$$P = V \times I \quad (3.1)$$

$$I = 20 \text{ W} / 18 \text{ V}$$

$$I = 1.11 \text{ A}$$

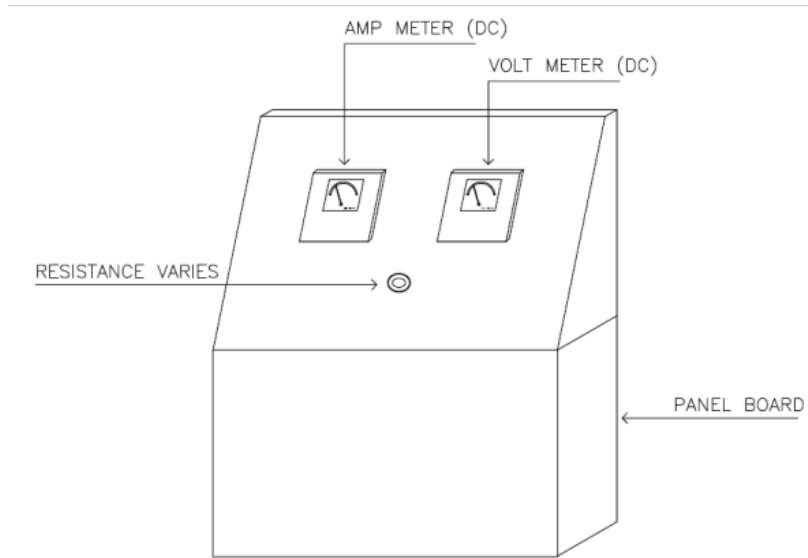
เพราะฉะนั้นค่าความต้านทานคำนวณจากสมการที่ 3.2 ดังนี้

$$V = I \times R \quad (3.2)$$

$$R = 18 \text{ V} / 1.11 \text{ A}$$

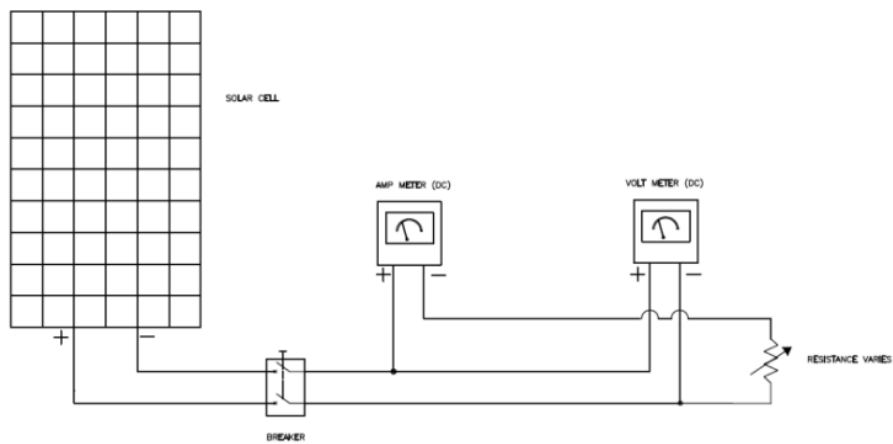
$$R = 16.21 \Omega$$

ดังนั้นความต้านทานปรับค่าได้จะใช้ขนาด 16.21Ω และแบบจำลองของชุดเครื่องมือวัดค่ากระแสและแรงดันแสดงดังภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 แบบจำลองชุดเครื่องมือวัดค่ากระแสและแรงดันของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ภาพจำลองวงจรของชุดทดลองแผงพลังงานแสงอาทิตย์แสดงดังภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 ภาพจำลองวงจรของชุดทดลองแผงพลังงานแสงอาทิตย์

จากการออกแบบเบื้องต้นได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชิ้นงานเพื่อให้เหมาะสมกับการทดลองมากยิ่งขึ้น โดยได้ออกแบบชุดฐานวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 ฐานวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ชุดเครื่องมือวัดพารามิเตอร์ต่างๆประกอบด้วย โวลต์มิเตอร์กระแสตรง และแอมป์มิเตอร์กระแสตรงประเภทดิจิทัล 1 ชุด และมีโหลดเป็นหลอดไฟ ขนาด 3 Watts 12 Volt จำนวน 8 ดวง ดังภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 ชุดเครื่องมือวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

ซึ่งหลอดไฟที่นำมาใช้เป็นโหลดสามารถคำนวณเป็นค่า Resistance ได้ดังนี้

$$P = V \times I$$

$$I = 3 \text{ W} / 12 \text{ V}$$

$$I = 0.25 \text{ A}$$

$$R = V / I$$

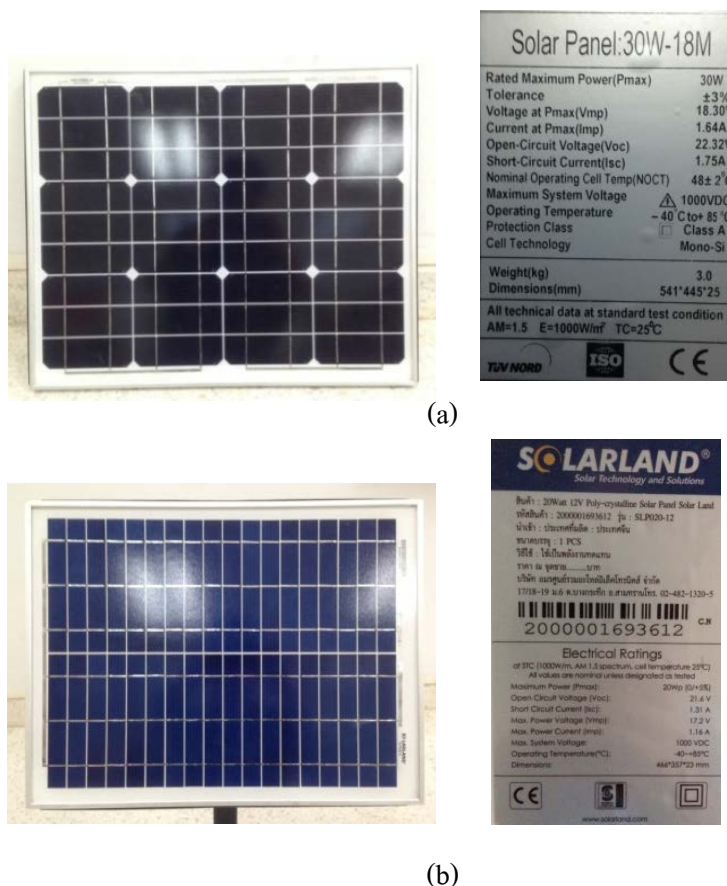
$$R = 12 \text{ V} / 0.25 \text{ A}$$

$$R = 48 \Omega$$

ดังนั้นหลอดไฟที่นำมาใช้เป็นโหลดจะมีค่าต่อวงจรเท่ากับ 48Ω

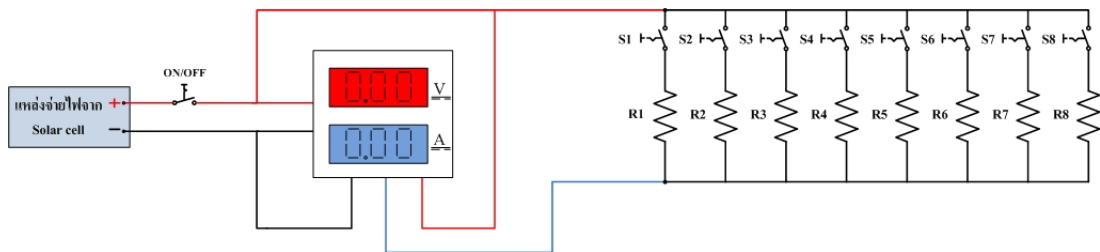
3.2 ชนิดของแผงที่ใช้งาน

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาใช้ศึกษาคือชนิด Mono Crystalline Silicon Cell และ Poly Crystalline Silicon Cell ส่วนชนิด Amorphous นั้นปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้กันจึงหาซื้อได้ยาก ทางผู้จัดทำโครงการจึงใช้เพียง 2 ชนิดในการศึกษาเท่านั้นดังภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 (a) แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Mono Crystalline Silicon Cell ขนาด 30 W และ (b) แผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Poly Crystalline Silicon Cell ขนาด 20 W

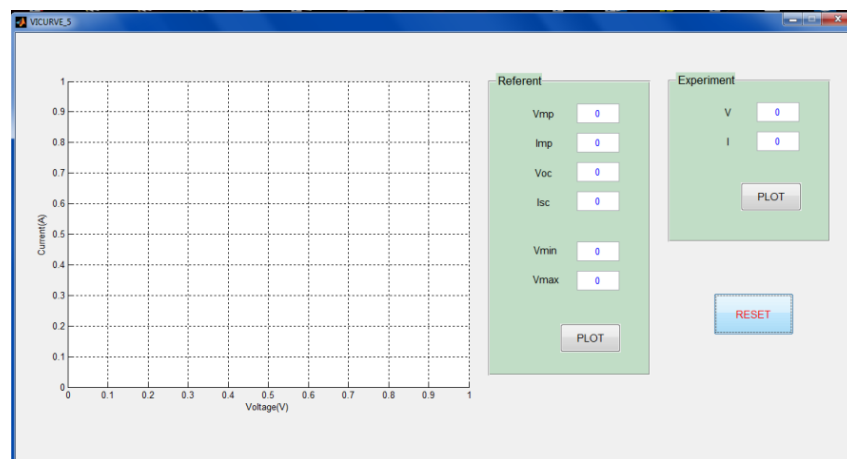
รูปวงจรของสื่อการเรียนรู้ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์แสดงดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 วงจรของสื่อการเรียนรู้ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

3.3 โปรแกรม Matlab

เนื่องจากโครงงานนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทางผู้จัดทำจึงได้ทำสื่อการเรียนรู้ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากยิ่งขึ้นจึงได้ใช้โปรแกรม Matlab มาช่วยในการพล็อตกราฟโดยใช้โปรแกรม GUI ซึ่งมีอยู่ใน ตัวโปรแกรมเป็นดังภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

ซึ่งในการเขียนโปรแกรมได้นำสูตรทางคณิตศาสตร์ของแบบจำลอง MIT I-V Model มาใช้ภายในชุดคำสั่ง เพื่อนำมาพล็อตเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสเทียบกับผลการทดลอง ดังภาพที่ 3.10 โดยที่ตัวโปรแกรมที่เป็น Software นั้นแนบอยู่ที่ภาคผนวก

```

280
281 % --- Executes on button press in PLOT.
282 function PLOT_Callback(hObject, eventdata, handles)
283 % hObject handle to PLOT (see GCBO)
284 % eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
285 % handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
286 set(handles.figure1,'HandleVisibility','on');
287 Vmin = str2num(get(handles.Vmin1,'String'));
288 Vmax = str2num(get(handles.Vmax1,'String'));
289 Vmp = str2num(get(handles.Vmp1,'String'));
290 Imp = str2num(get(handles.Imp1,'String'));
291 Voc = str2num(get(handles.Voc1,'String'));
292 Isc = str2num(get(handles.Isc1,'String'));
293 C2 = ((Vmp/Voc)-1)/(log(1-(Imp/Isc)));
294 C1 = (1-(Imp/Isc))*(exp(-Vmp/(C2*Voc)));
295 V = linspace(Vmin,Vmax,200);
296 I = Isc*(1-(C1*(exp(V/(C2*Voc))-1)));
297 LinePlot = plot(V,I);
298 handles.LineX = LinePlot;
299 xlabel('Voltage (V)');
300 ylabel('Current (A)');
301 guidata(gcbo,handles);
302 set(handles.figure1,'HandleVisibility','off');
303

```

ภาพที่ 3.10 ชุดคำสั่งที่อ้างอิงสูตรการคำนวณของแบบจำลอง MITI-V Model

และโครงการนี้ได้ออกแบบใบงานเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 1 ชุดสำหรับบันทึกค่าพารามิเตอร์ต่างๆสำหรับห้องปฏิบัติการแสดงในภาคผนวก

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 วิธีการทดลอง

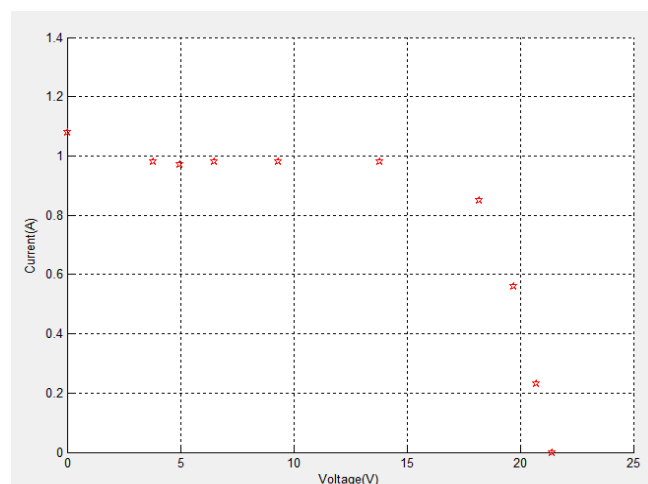
1. ทำการปรับตั้งฐานวางแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้ทำมุมตั้งฉากกับแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด แล้วนำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องการทดสอบมาวางเพื่อรับแสง
2. ต่อชุดเครื่องมือวัดค่ากระแสและแรงดันเข้ากับชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์จากนั้นทำการวัดค่ากระแสลัดวงจรและแรงดันเปิดวงจร
3. ทำการจ่ายโหลดโดยการสับสวิทช์ของหลอดไฟที่ละหลอดจนครบจำนวนหลอด
4. บันทึกค่ากระแสและแรงดันที่อ่านค่าได้แต่ละหลอด
5. นำข้อมูลที่บันทึกได้ไปพล็อตกราฟเพื่อเปรียบเทียบกับ Reference เพื่อเรียนรู้คุณลักษณะและพฤติกรรมของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

4.2 ผลการทดลองของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Mono Crystalline Silicon Cell ขนาด 30 W

ตารางที่ 4.1 บันทึกผลครั้งที่ 1

$$I_{sc} = 1.08 \text{ A}, V_{oc} = 21.4 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	20.70	0.23	4.761
R 2	19.70	0.56	11.032
R 3	18.20	0.85	15.47
R 4	13.80	0.98	13.524
R 5	9.32	0.98	9.1336
R 6	6.50	0.98	6.37
R 7	4.96	0.97	4.8112
R 8	3.80	0.98	3.724

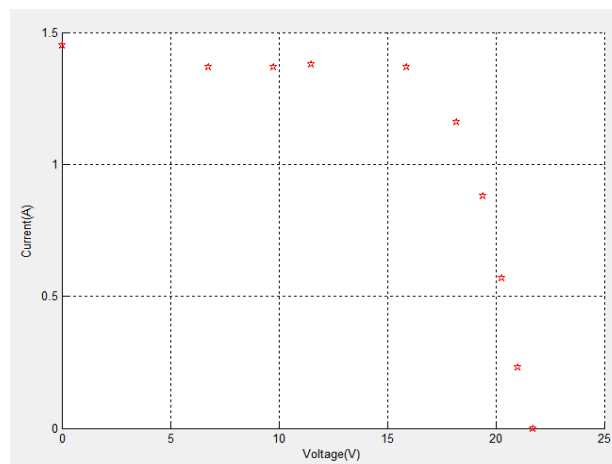


ภาพที่ 4.1 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.2 บันทึกผลครั้งที่ 2

$$I_{sc} = 1.45 \text{ A}, V_{oc} = 21.7 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	21.0	0.23	4.83
R 2	20.30	0.57	11.571
R 3	19.40	0.88	17.072
R 4	18.20	1.16	21.112
R 5	15.90	1.37	21.783
R 6	11.50	1.38	15.87
R 7	9.75	1.37	13.358
R 8	6.75	1.37	9.248

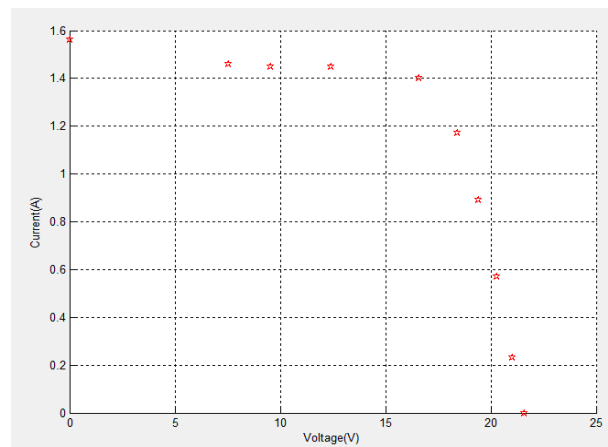


ภาพที่ 4.2 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.3 บันทึกผลครั้งที่ 3

$$I_{sc} = 1.56 \text{ A}, V_{oc} = 21.6 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	21.00	0.23	4.83
R 2	20.30	0.57	11.571
R 3	19.40	0.89	17.266
R 4	18.40	1.17	21.528
R 5	16.60	1.40	23.24
R 6	12.40	1.45	17.98
R 7	9.53	1.45	13.82
R 8	7.55	1.46	11.023

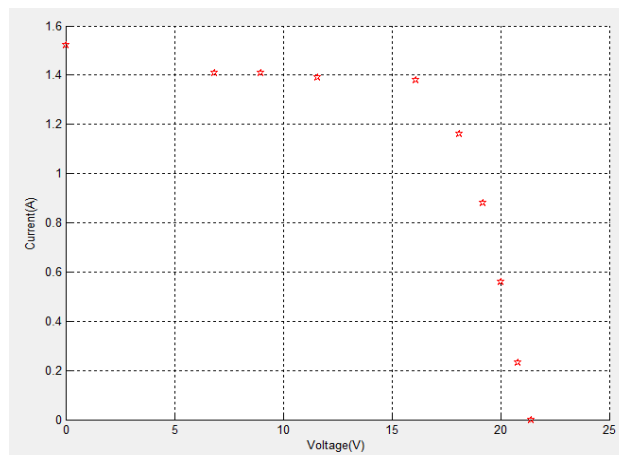


ภาพที่ 4.3 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.4 บันทึกผลครั้งที่ 4

$$I_{sc} = 1.52 \text{ A}, V_{oc} = 21.4 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	20.80	0.23	4.784
R 2	20.00	0.56	11.20
R 3	19.20	0.88	16.896
R 4	18.10	1.16	20.996
R 5	16.10	1.38	22.218
R 6	11.60	1.39	16.124
R 7	8.99	1.41	12.676
R 8	6.86	1.41	9.673

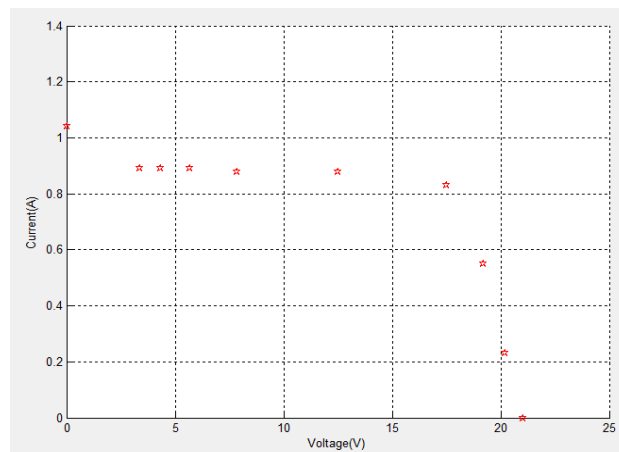


ภาพที่ 4.4 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.5 บันทึกผลครั้งที่ 5

$$I_{sc} = 1.04 \text{ A}, V_{oc} = 21.0 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	20.2	0.23	4.646
R 2	19.20	0.55	10.56
R 3	17.50	0.83	14.525
R 4	12.50	0.88	11.00
R 5	7.84	0.88	6.899
R 6	5.69	0.89	5.0641
R 7	4.34	0.89	3.8626
R 8	3.36	0.89	2.9904



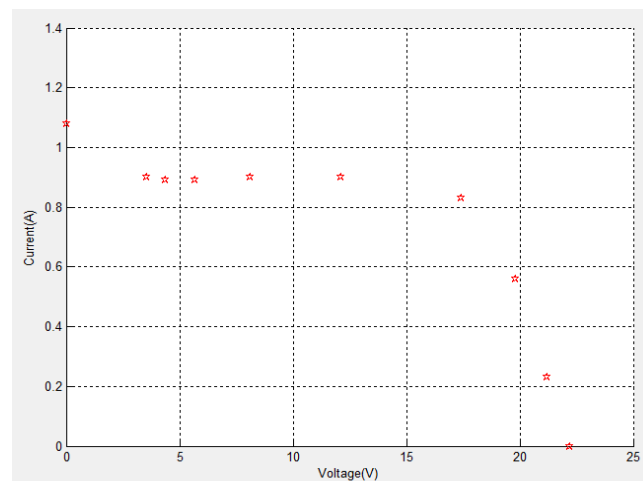
ภาพที่ 4.5 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.5

4.3 ผลการทดลองของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ Poly Crystalline Silicon Cell ขนาด 20 W

ตารางที่ 4.6 บันทึกผลครั้งที่ 1

$$I_{sc} = 1.08 \text{ A}, V_{oc} = 22.2 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	21.20	0.23	4.876
R 2	19.80	0.56	11.088
R 3	17.40	0.83	14.442
R 4	12.10	0.90	10.89
R 5	8.12	0.90	7.308
R 6	5.69	0.89	5.064
R 7	4.35	0.89	3.871
R 8	3.55	0.90	3.195

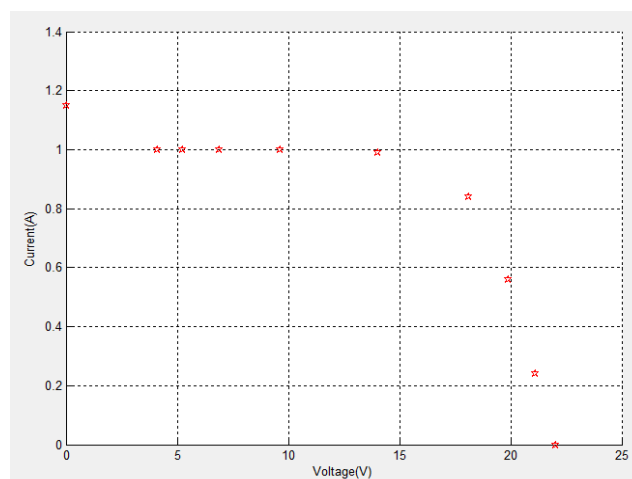


ภาพที่ 4.6 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.7 บันทึกผลครั้งที่ 2

$$I_{sc} = 1.15 \text{ A}, V_{oc} = 22.0 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	21.10	0.24	5.064
R 2	19.90	0.56	11.144
R 3	18.10	0.84	15.204
R 4	14.00	0.99	13.86
R 5	9.64	1.00	9.64
R 6	6.90	1.00	6.90
R 7	5.25	1.00	5.25
R 8	4.13	1.00	4.13

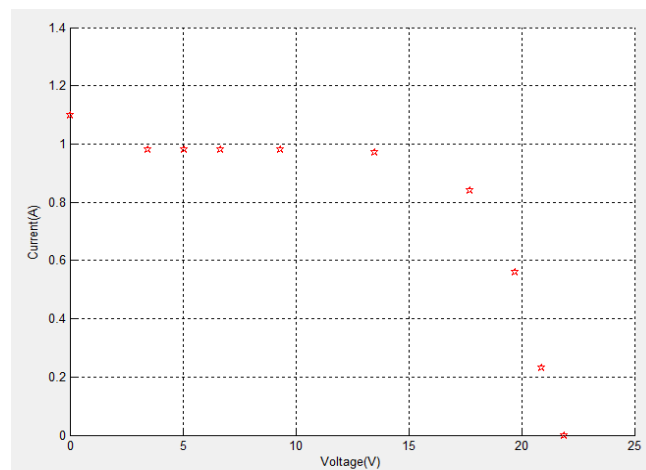


ภาพที่ 4.7 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.8 บันทึกผลครั้งที่ 3

$$I_{sc} = 1.10 \text{ A}, V_{oc} = 21.9 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	20.90	0.23	4.807
R 2	19.70	0.56	11.032
R 3	17.70	0.84	14.868
R 4	13.50	0.97	13.095
R 5	9.34	0.98	9.1532
R 6	6.67	0.99	6.6033
R 7	5.07	0.98	4.9686
R 8	3.44	0.98	3.3712

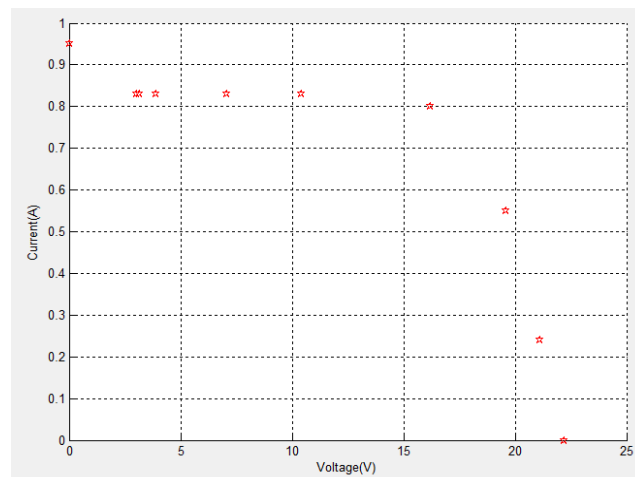


ภาพที่ 4.8 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.9 บันทึกผลครั้งที่ 4

$$I_{sc} = 0.95 \text{ A}, V_{oc} = 22.2 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	21.10	0.24	5.064
R 2	19.60	0.55	10.78
R 3	16.20	0.80	12.96
R 4	10.4	0.83	8.632
R 5	7.07	0.83	5.868
R 6	3.88	0.83	3.2204
R 7	3.15	0.83	2.6145
R 8	3.00	0.83	2.49

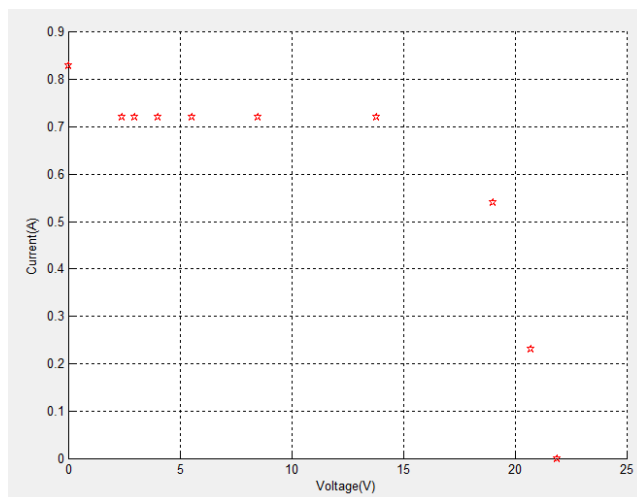


ภาพที่ 4.9 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.10 บันทึกผลครั้งที่ 5

$$I_{sc} = 0.83 \text{ A}, V_{oc} = 21.9 \text{ V}$$

R (Ω)	V (V)	I (A)	P (W)
R 1	20.70	0.23	4.761
R 2	19.00	0.54	10.26
R 3	13.80	0.72	9.936
R 4	8.50	0.72	6.12
R 5	5.53	0.72	3.9816
R 6	4.00	0.72	2.88
R 7	2.98	0.72	2.1456
R 8	2.42	0.72	1.7424

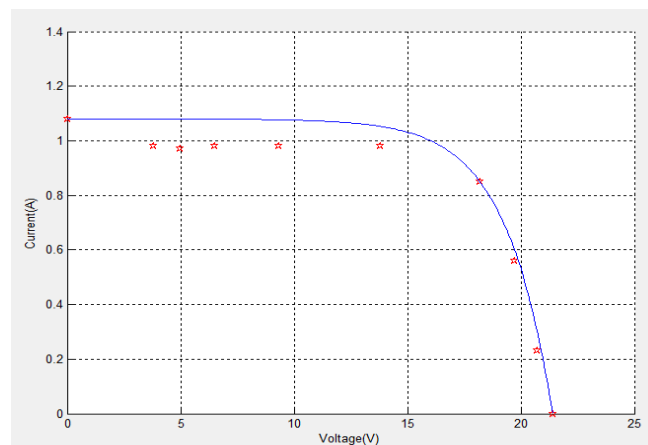


ภาพที่ 4.10 แสดงกระแสและแรงดันของตารางที่ 4.10

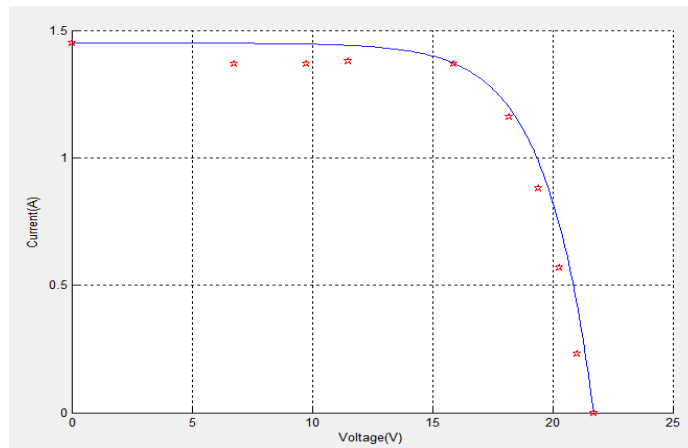
4.4 ผลการทดลอง

1. การทดลองแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Mono Crystalline Silicon Cell ขนาด 30 Watts ได้ทำการทดลองจำนวน 5 ครั้ง ผลการทดลองได้ค่ากระแสและแรงดันตามตารางที่ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 และ 4.5 ตามลำดับ และเมื่อนำค่ากระแสและแรงดันของการทดลองแต่ละครั้งมาพล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันจะได้ดังภาพที่ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ตามลำดับ

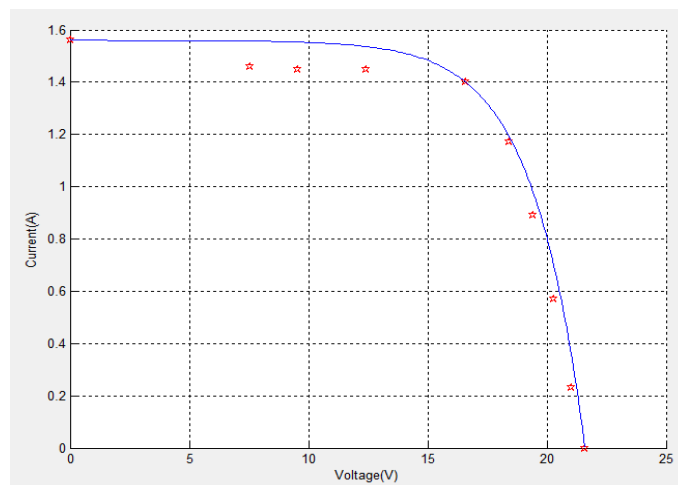
จากการทดลองเมื่อทำการเพิ่มโหลดเข้าไปจะพบว่าค่าแรงดันที่วัดได้จะมีค่าลดลง ส่วนกระแสที่วัดได้จะมีค่าเพิ่มขึ้น จนถึงจุดหนึ่งค่ากระแสจะเริ่มคงที่ และจะมีจุดหนึ่งที่จะมีการจ่ายค่ากำลังงานสูงสุดดังที่ได้ทำการป้ายแถบสีไว้ในแต่ละตารางการทดลอง เมื่อนำค่ากระแสและแรงดันของการทดลองในแต่ละครั้งมาพล็อตเทียบกับ V-I Curve ที่ได้จากค่าพารามิเตอร์ของแผงจากผู้ผลิตจะแสดงดังภาพที่ 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 และ 4.15 ตามลำดับ



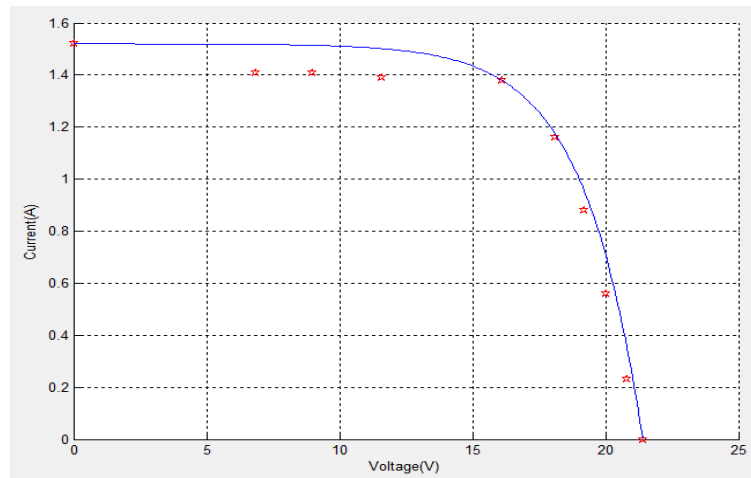
ภาพที่ 4.11 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.1



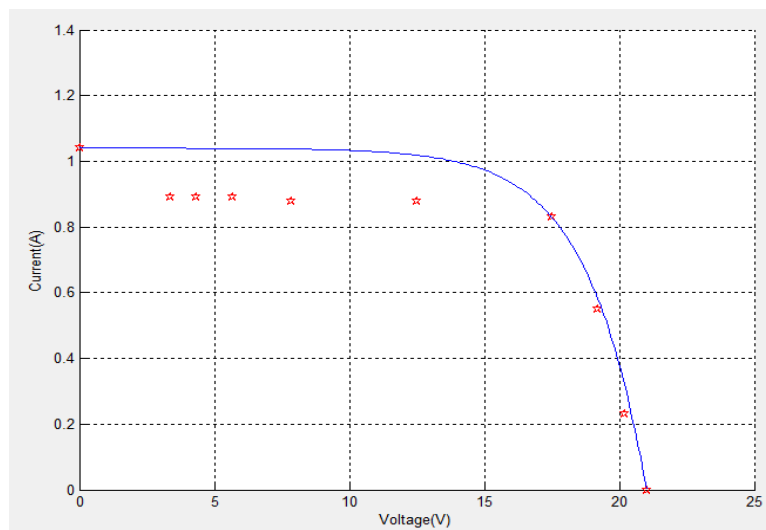
ภาพที่ 4.12 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.2



ภาพที่ 4.13 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.3



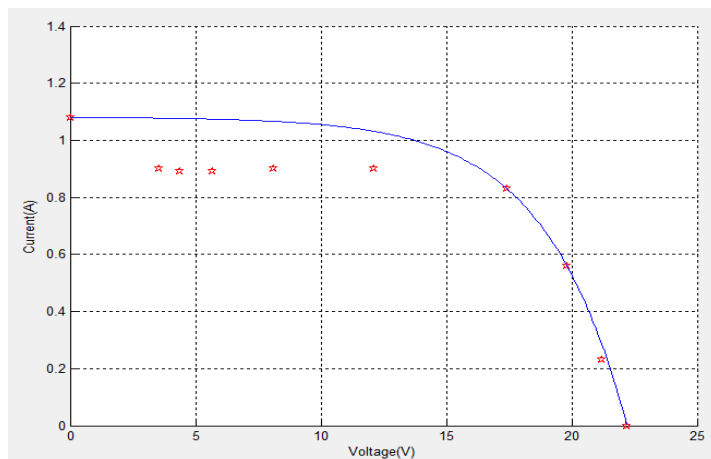
ภาพที่ 4.14 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.4



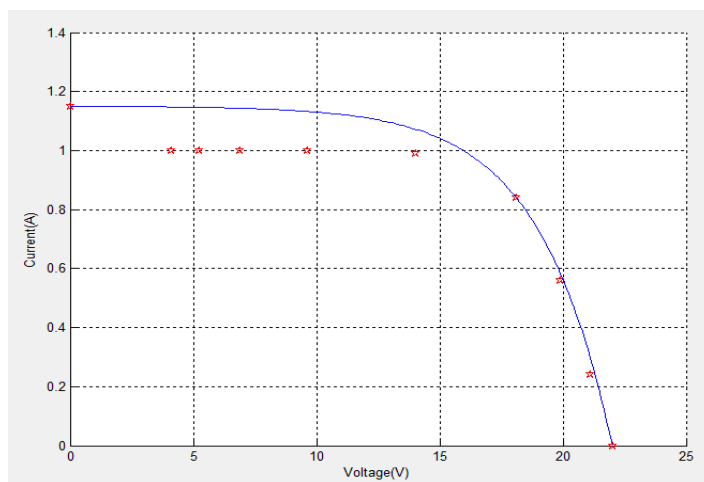
ภาพที่ 4.15 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.5

2. การทดลองแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิด Poly Crystalline Silicon Cell ขนาด 20 Watts ได้ทำการทดลองจำนวน 5 ครั้ง ผลการทดลองได้ค่ากระแสและแรงดันตามตารางที่ 4.6 , 4.7, 4.8, 4.9 และ 4.10 ตามลำดับ และเมื่อนำค่ากระแสและแรงดันจากการทดลองแต่ละครั้งมาพล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันจะได้ดังภาพที่ 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 ตามลำดับ

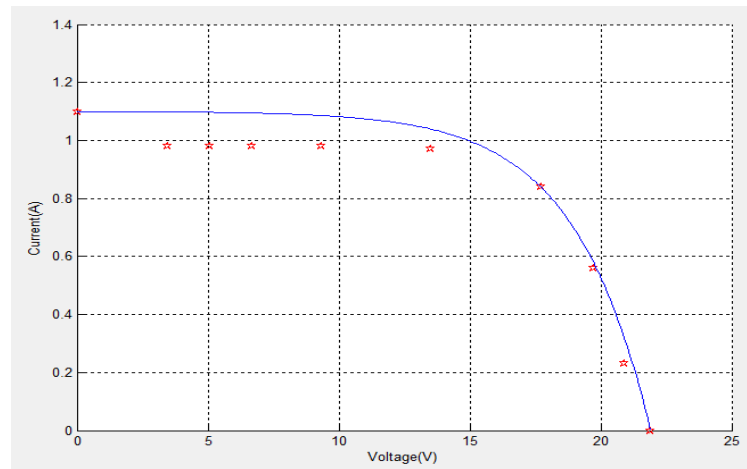
จากการทดลองเมื่อทำการเพิ่มโหลดเข้าไปจะพบว่าค่าแรงดันที่วัดได้จะมีค่าลดลง ส่วนกระแสที่วัดได้จะมีค่าเพิ่มขึ้น จนถึงจุดหนึ่งค่ากระแสจะเริ่มคงที่ และจะมีจุดหนึ่งที่จะมีการจ่ายค่ากำลังงานสูงสุดดังที่ได้ทำการป้ายแถบสีไว้ในแต่ละตารางการทดลอง เมื่อนำค่ากระแสและแรงดันของการทดลองในแต่ละครั้งมาพล็อตเทียบกับ V-I curve ที่ได้จากค่าพารามิเตอร์ของแผงจากทางผู้ผลิตจะแสดงดังภาพที่ 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 และ 4.20



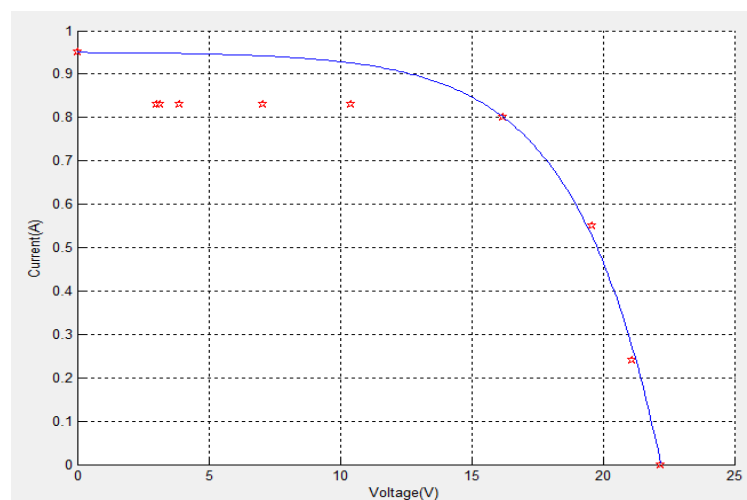
ภาพที่ 4.16 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.6



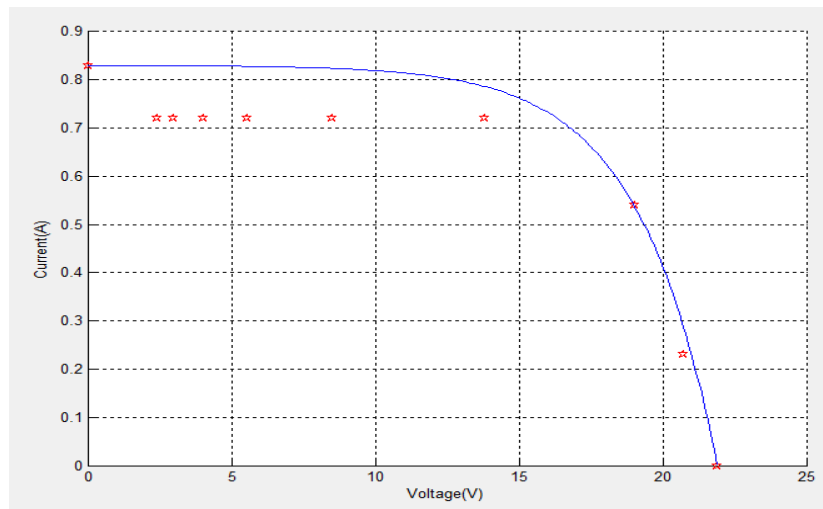
ภาพที่ 4.17 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.7



ภาพที่ 4.18 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.8



ภาพที่ 4.19 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model ของตารางที่ 4.9



ภาพที่ 4.20 แสดงกระแสและแรงดันจากการทดลองเปรียบเทียบกับ MIT I-V Model
ของตารางที่ 4.10

บทที่ 5

สรุป

โครงการสอนการเรียนรู้คุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้ศึกษาแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 2 ชนิด คือ Single Crystalline Silicon Cell และ Poly Crystalline Silicon Cell ที่ผู้จัดทำโครงการได้ทดลอง ด้วยการใส่โปรแกรมจำลองของกระแส และแรงดัน พบว่าสอดคล้องกับสมการของแบบจำลองที่นำมาศึกษาคือ MIT I-V Model และชุดปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นคุณสมบัติและพฤติกรรมของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยให้เป็นการเรียน การสอน ในเรื่องคุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากโครงการนี้จะสังเกตได้ว่าค่ากระแส และแรงดันจากการทดลองนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพารามิเตอร์ จากสเป็กของแผงที่พล็อตออกมาเป็น Reference นั้น ค่าจากการทดลองจะอยู่ต่ำกว่าเส้น กราฟดังกล่าว เนื่องจากสเป็กของแผงจากผู้ผลิตนั้น ได้ทดสอบจากค่า 1000 W/m^2 ซึ่งการทดลองจริงนั้น ไม่สามารถกำหนดแสงอาทิตย์ให้อยู่ในค่าที่ผู้ผลิตได้กำหนดมา กราฟที่ได้จากการทดลองจึงมีค่าที่ไม่ใกล้เคียงมากนักกับเส้น Reference ที่กำหนดมากับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ก็มีแนวโน้มแบบเดียวกันกับกราฟ Reference ของทางผู้ผลิต

โครงการนี้ได้ใช้โปรแกรม GUI เป็นสื่อการเรียนรู้ให้เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง โปรแกรมที่จัดทำขึ้นมานั้นทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และสูตรทางคณิตศาสตร์ของ MIT I-V Model นั้น ไม่ยุ่งยากไม่มีความซับซ้อนจึงเหมาะที่จะนำมาเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายแก่ผู้ที่สนใจและต้องการศึกษา

การทดลองของโครงการการเรียนรู้คุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เบื้องต้นได้ศึกษาแผงพลังงานทั้งหมด 3 ชนิด แต่ตามท้องตลาดมีจำหน่ายเพียง 2 ชนิด คือ Single Crystalline Silicon Cell และ Poly Crystalline Silicon Cell จึงได้ทำการทดลองเพียง 2 ชนิด ในระหว่างที่ทำการทดลองนั้นพบปัญหาในการทดลองคือในช่วงเวลาของแต่ละวันนั้นแสงอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากปัจจัยของสภาพอากาศและอุณหภูมิจึงมีผลให้แรงดันและกระแสที่วัดค่าได้ไม่คงที่

เอกสารอ้างอิง

- [1] Timothy U. Townsend, "A method for estimating the long-term performance of direct-coupled photovoltaic system" A thesis submitted in partial fulfillment of requirements for the degree of mechanical engineering at I University of Wisconsin-Madison, 1989
- [2] กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝ่ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2554
- [3] คุณิต เครื่องงาม และคณะฯ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 1990
- [4] อธิรุฒิ วงศ์สาลี, นายพงษ์ศิริ นุบผามาลัย "การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ขณะฝนตก" ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2555
- [5] ชัชวาล เชื้อววิทย์พันธ์, ภาสกร พรเจริญนพ, เอกชัย ว่องทรัพย์สิน "เซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ตามตำแหน่งดวงอาทิตย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2553
- [6] อุมารินทร์ แสงพานิช "การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าของระบบโซลาร์เซลล์ที่เชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงอาทิตย์" วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545

ภาคผนวก

ตัวอย่างใบงานการทดลอง

ใบงานการทดลอง

สู่การเรียนรู้คุณสมบัติของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติและพฤติกรรมของแผงพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (I) และแรงดัน (V) ของเซลล์แสงอาทิตย์
3. เพื่อหาจุดสูงสุดในการจ่ายกำลังงาน (Maximum Power Point : MPP)

อุปกรณ์การทดลอง

1. แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Mono Crystal ขนาด 30 W
2. แผงโซลาร์เซลล์ชนิด Poly Crystal ขนาด 20 W
3. แอมป์มิเตอร์กระแสตรง
4. โวลต์มิเตอร์กระแสตรง

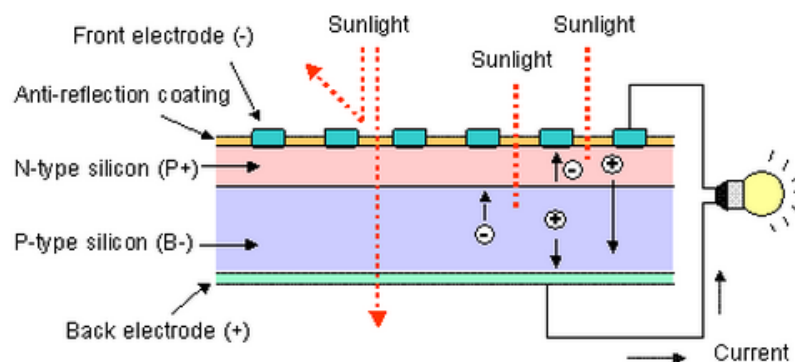
ทฤษฎีเบื้องต้น

1. บทนำ

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่มีปริมาณมาก สะอาดและไม่มีมลพิษ สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ประโยชน์ได้สูงสุด เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละประเภทมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเข้มของแสง, อุณหภูมิ, วัสดุที่ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษา คุณสมบัติพฤติกรรม และประสิทธิภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเรียนรู้และนำไปพัฒนาให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น

2. หลักการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

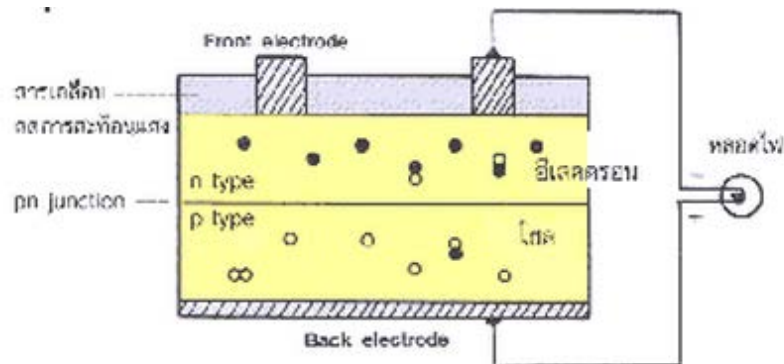
การทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นขบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานกระทบกับสารกึ่งตัวนำ จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า (อิเล็กตรอน) ขึ้นในสารกึ่งตัวนำ จึงสามารถต่อกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไปใช้งานได้ (ตามรูป)



รูปที่ 2.1 หลักการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์

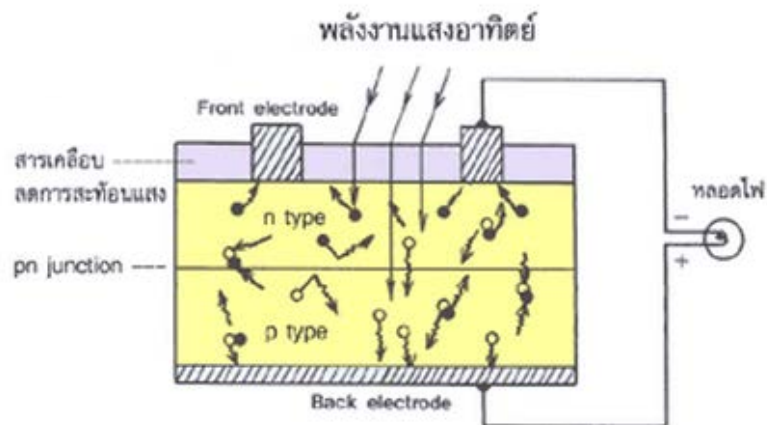
ขั้นตอนการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์มีดังนี้

1. n - type ซิลิคอน ซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ คือ สารกึ่งตัวนำที่ได้อุปโภคโดยโป้งด้วยสารฟอสฟอรัส มีคุณสมบัติเป็นตัวให้อิเล็กตรอนเมื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ p - type ซิลิคอน คือ สารกึ่งตัวนำที่ได้อุปโภคโดยโป้งด้วยสารโบรอน ทำให้โครงสร้างของอะตอมสูญเสียอิเล็กตรอน (โฮล) เมื่อรับพลังงาน จากแสงอาทิตย์จะทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน เมื่อนำซิลิคอนทั้ง 2 ชนิด มาประกบต่อกันด้วย p - n junction จึงทำให้เกิดเป็น " เซลล์แสงอาทิตย์ " ในสถานะที่ยังไม่มีแสงแดด n - type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหน้าของเซลล์ ส่วนประกอบส่วนใหญ่พร้อมจะให้อิเล็กตรอน แต่ก็ยังมีโฮลปะปนอยู่บ้างเล็กน้อย ด้านหน้าของ n - type จะมีแถบโลหะเรียกว่า Front Electrode ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน ส่วน p - type ซิลิคอนซึ่งอยู่ด้านหลังของเซลล์ โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นโฮล แต่ยังคงมีอิเล็กตรอนปะปนบ้างเล็กน้อย ด้านหลังของ p - type ซิลิคอนจะมีแถบโลหะเรียกว่า Back Electrode ทำหน้าที่เป็นตัวรวบรวมโฮล ตามรูปที่ 2.2



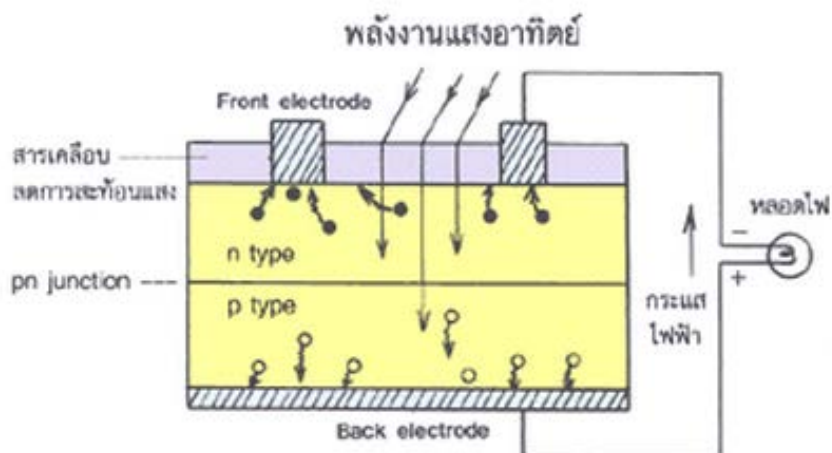
รูปที่ 2.2 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

2. เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบ แสงอาทิตย์จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอนและโฮล ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว เมื่อพลังสูงพอทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเข้าหาเพื่อจับคู่กัน อิเล็กตรอนจะวิ่งไปยังชั้น n - type และโฮลจะวิ่งไปยังชั้น p type ตามรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

3. อิเล็กตรอนวิ่งไปรวมกันที่ Front Electrode และโฮลวิ่งไปรวมกันที่ Back Electrode เมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode และ Back Electrode ให้ครบวงจร ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เนื่องจากทั้งอิเล็กตรอนและโฮลจะวิ่งเพื่อจับคู่กัน ตามรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์

3. ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์

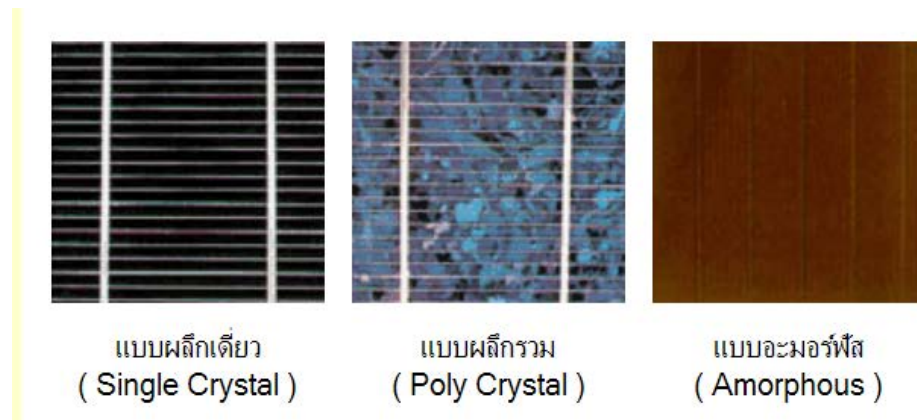
เซลล์แสงอาทิตย์ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือ

3.1 กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้น คือ แบบที่เป็น รูปผลึก (Crystal) และแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) แบบที่เป็นรูปผลึก จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Single Crystalline Silicon Solar Cell) และ ชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก คือ ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell)

3.2 กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำจากสารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน ซึ่งประเภทนี้จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ขึ้นไป แต่มีราคาสูงมาก ไม่นิยมนำมาใช้บนพื้นโลก จึงใช้งานสำหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่การพัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่จะทำให้มีราคาถูกลงและนำมาใช้มากขึ้นในอนาคต (ปัจจุบันนำมาใช้เพียง 7 % ของปริมาณที่มีใช้ทั้งหมด)

ในที่นี้จะกล่าวถึงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ผลิตจากซิลิคอน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. ซิลิคอนแบบผลึกเดี่ยว (Single Crystalline Silicon Cell)
2. ซิลิคอนแบบหลายผลึก (Poly Crystalline Silicon Cell)
3. ซิลิคอนแบบไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous Silicon Cell)



รูปที่ 3.1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทซิลิกอนชนิดต่างๆ

4. ทฤษฎีแบบจำลอง MIT I-V MODEL

4.1 MIT I-V Model Equivalent Circuit แบบจำลอง I-V นี้เป็นการผสมระหว่าง L3P และ L4P ซึ่งในโครงการนี้ได้เลือกใช้รูปแบบโมเดลนี้ เนื่องจากทำความเข้าใจได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันเป็นดังนี้

$$I = I_{sc} \left[1 - C_1 \left(\exp \left(\frac{V}{C_2 V_{oc}} \right) - 1 \right) \right]$$

ค่าคงที่ C_1 และ C_2 หา ดังนี้

$$C_1 = \left(1 - \frac{I_{MP}}{I_{sc}} \right) \exp \left(\frac{-V_{MP}}{C_2 V_{oc}} \right)$$

$$C_2 = \frac{\frac{V_{MP}-1}{V_{oc}}}{\ln \left(1 - \frac{I_{MP}}{I_{sc}} \right)}$$

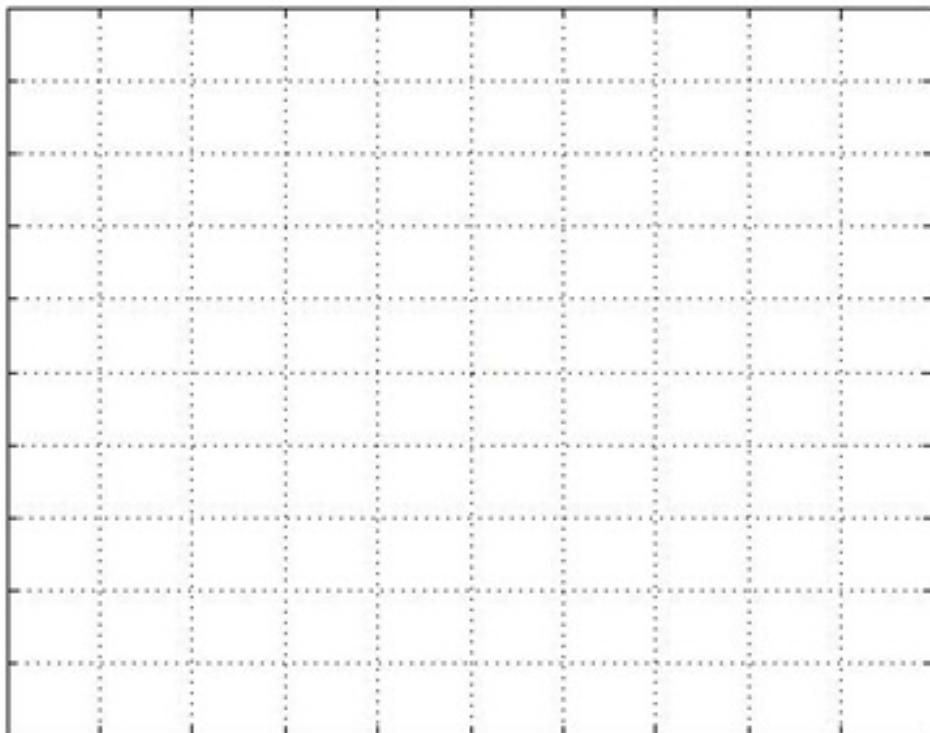
2.2 ตารางค่า Poly Silicon Crystalline Cell

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
I (A)								
V (V)								

หมายเหตุ : ใช้โปรแกรม GUI เพื่อพล็อตกราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดัน

3. วาดไดอะแกรมของ กระแส (I) และ แรงดัน (V)

3.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (I) และ แรงดัน (V) ของค่า Single Silicon Crystalline Cell เปรียบเทียบกับแบบจำลอง MIT I-V Model



3.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแส (I) และ แรงดัน (V) ของค่า Poly Silicon Crystalline Cell เปรียบเทียบกับแบบจำลอง MIT I-V Model

